【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成29年7月20日(2017.7.20)

【公開番号】特開2016-85287(P2016-85287A)
【公開日】平成28年5月19日(2016.5.19)
【年通号数】公開・登録公報2016-030
【出願番号】特願2014-216489(P2014-216489)
【国際特許分類】
Ｇ０２Ｆ　1/1343　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/027　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/28　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０２Ｆ　1/1343
Ｈ０１Ｌ　21/30　５７０
Ｈ０１Ｌ　21/28　Ｅ
Ｈ０１Ｌ　21/28　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月9日(2017.6.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
基板上に画素電極のパターンを形成する方法であって、
基板上の画素電極層の上面に、前記パターンの第１のスペース部となる部分にレジストを形成し、
その後前記レジストが形成された画素電極層上に犠牲膜を形成し、
その後前記レジストの側部の残置犠牲膜を残して、前記犠牲膜を除去し、画素電極層の上面に前記パターンの第２のスペース部を形成し、
その後前記レジストを除去して、前記パターンの第１のスペース部を形成し、
その後前記第１のスペース部、第２のスペース部の側方に、コンタクト部のレジストを形成し、
その後前記第１のスペース部、第２のスペース部の画素電極層を除去することを特徴とする、画素電極のパターン形成方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
前記の目的を達成するため、本発明は、基板上に画素電極のパターンを形成する方法であって、基板上の画素電極層の上面に、前記パターンの第１のスペース部となる部分にレジストを形成し、その後前記レジストが形成された画素電極層上に犠牲膜を形成し、その後前記レジストの側部の残置犠牲膜を残して、前記犠牲膜を除去し、画素電極層の上面に前記パターンの第２のスペース部を形成し、その後前記レジストを除去して、前記パターンの第１のスペース部を形成し、その後前記第１のスペース部、第２のスペース部の側方に、コンタクト部のレジストを形成し、その後前記第１のスペース部、第２のスペース部

の画素電極層を除去することを特徴としている。